

 応用物理学会応用電子物性分科会主催

## 応用電子物性分科会研究例会

協賛：大阪大学グローバルCOEプログラム「次世代電子デバイス教育研究開発拠点」

# 窒化物半導体発光デバイスの最前線

## － 有極性・非極性発光デバイスを徹底検証する －

窒化物半導体光デバイスは、青色および白色発光ダイオード、ブルーレイ用半導体レーザー等として我々の生活で身近に用いられています。さらなる特性改善の為に、結晶内部に存在するピエゾ電界を解消するアプローチがあります。その具体策が、非極性面上での結晶成長と素子化です。本研究会においては、非極性面上に作製された窒化物半導体光デバイス開発における最新の研究を御紹介いただくと共に、将来展望を議論することを目的としています。

<http://annex.jsap.or.jp/support/division/ohden/>

開催日時：2008年12月5日（金）13:00～17:45（開場12:30）

場所：大阪大学吹田キャンパス 银杏会館3階 阪急電鉄・三和銀行ホール

（大阪府吹田市山田丘2-2 <http://www.ichou.or.jp/access/access.html>）

演題：

- (1) **非極性面上 InGaN 量子井戸の偏光特性の理論解析**  
13:10～13:45 山口敦（金沢工大）
- (2) **AlGaN 紫外半導体レーザー**  
13:45～14:20 吉田治正，山下陽滋，桑原正和，菅博文（浜松ホトニクス中研）
- (3) **半極性面を利用した窒化物半導体発光デバイスとその物性**  
14:20～14:55 船戸充，川上養一（京都大学）  
—休憩（20分）—
- (4) **（特別講演）Recent Performance of Nonpolar/Semipolar/Polar GaN-based Blue LEDs and LDs**  
15:15～16:05 S.Nakamura, S. P. DenBaars, J. S. Speck, M. C. Schmidt, K-C Kim, R. M. Farrell, D. F. Feezell, D. A. Cohen, M. Saito, H. Sato, H. Asamizu, A. Tyagi, H. Zhong, H. Masui, N. N. Fellows, T. Hashimoto, M. IZA (University of California, Santa Barbara)  
K. Fujito (Mitsubishi Chemical Corporation)
- (5) **無極性基板を用いた窒化物半導体レーザー**  
16:05～16:40 津田有三，太田征孝，Pablo O. Vaccaro，神川剛，蛭川秀一，川口佳伸，藤城芳江，高倉輝芳，高平宣幸，湯浅貴之，上田吉裕（シャープ）
- (6) **非極性 m 面 InGaN 青緑色レーザーダイオードの開発**  
16:40～17:15 久保田将司，柏木淳一，田中岳利，岡本國美（ローム）
- (7) **総合討論** 17:15～17:45

参加費：当日受付（テキスト代・消費税込み）

分科会会員：無料、応用物理学会会員（非分科会会員）：3,000円、

一般：4,000円、学生：1,000円

問合せ先：

近藤正彦（大阪大学）	<a href="mailto:kondow@eei.eng.osaka-u.ac.jp">kondow@eei.eng.osaka-u.ac.jp</a>
平松和政（三重大学）	<a href="mailto:hiramatu@elec.mie-u.ac.jp">hiramatu@elec.mie-u.ac.jp</a>
原田佳幸（東芝）	<a href="mailto:yoshiyuki.harada@toshiba.co.jp">yoshiyuki.harada@toshiba.co.jp</a>
笹岡千秋（NEC エレ）	<a href="mailto:chiaki.sasaoka@necel.com">chiaki.sasaoka@necel.com</a>